



(19) 대한민국특허청(KR)  
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2011년10월17일  
(11) 등록번호 10-1074550  
(24) 등록일자 2011년10월11일

(51) Int. Cl.

H01L 23/36 (2006.01) H01L 23/15 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2009-0132958

(22) 출원일자 2009년12월29일

심사청구일자 2009년12월29일

(65) 공개번호 10-2011-0076286

(43) 공개일자 2011년07월06일

(56) 선행기술조사문헌

US20080224329 A1

KR100790527 B1

KR100370398 B1

(73) 특허권자

엘에스산전 주식회사

경기도 안양시 동안구 호계동 1026-6

(72) 발명자

김영평

경기도 수원시 장안구 정자동 백설마을 코오롱아파트 582동 1301호

임현창

경기도 부천시 원미구 심곡동 140-4 보보스오피스텔 510호

장동근

경기도 부천시 원미구 상2동 푸른마을2509 -1003

(74) 대리인

진천용, 정종욱, 조현동

전체 청구항 수 : 총 8 항

심사관 : 구분경

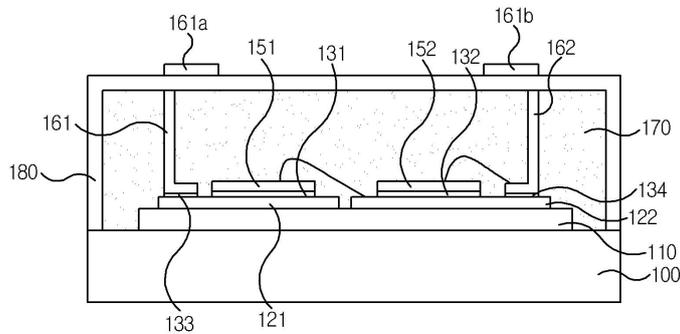
(54) 파워 모듈 및 그의 제조 방법

(57) 요약

본 발명은 파워 모듈 및 그의 제조 방법에 관한 것이다.

따라서, 본 발명의 파워 모듈은 베이스 기판과; 상기 베이스 기판 상부에 형성된 세라믹 코팅층과; 상기 세라믹 코팅층 상부에 형성되고 이격된 도전층들과; 상기 도전층들 상부 각각에 솔더층으로 분당된 파워 칩들을 포함하여 구성된다.

대표도 - 도1



**특허청구의 범위**

**청구항 1**

베이스 기판과;

상기 베이스 기판 상부에 형성된 세라믹 코팅층과;

상기 세라믹 코팅층 상부에 형성되고 이격된 제 1과 2 도전층들과;

상기 제 1과 2 도전층들 상부 각각에 솔더층으로 본딩된 제 1과 2 파워 칩들과;

상기 제 1과 2 파워 칩들을 내장하는 케이스와;

상기 케이스 상부에 형성된 제 1 터미널 단자에 연결되고, 상기 제 1 도전층에 제 3 솔더층으로 연결된 제 1 핀과;

상기 케이스 상부에 형성된 제 2 터미널 단자에 연결되고, 상기 제 2 도전층에 제 4 솔더층으로 연결된 제 2 핀과;

상기 제 1 파워 칩과 상기 제 2 도전층에 본딩되어 있고, 상기 제 2 파워 칩과 상기 제 2 핀에 본딩되어 있는 와이어들과;

상기 케이스 내부에 충전된 겔을 포함하여 구성된 파워 모듈.

**청구항 2**

청구항 1에 있어서,

상기 기판은,

히트 싱크인 파워 모듈.

**청구항 3**

청구항 1 또는 2에 있어서,

상기 세라믹 코팅층은,

$\text{SiO}_2$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{AlN}$ ,  $\text{Si}_3\text{N}_4$ ,  $\text{BeO}$  중 하나로 형성된 세라믹 코팅층인 것을 특징으로 하는 파워 모듈.

**청구항 4**

청구항 1 또는 2에 있어서,

상기 세라믹 코팅층은,

$\text{SiO}_2$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{AlN}$ ,  $\text{Si}_3\text{N}_4$ ,  $\text{BeO}$  중 하나를 포함하는 세라믹 분말을 페이스트 상태로 인쇄 또는 제트(Jet) 분사 방법으로 형성되어진 세라믹 코팅층인 것을 특징으로 하는 파워 모듈.

**청구항 5**

청구항 1 또는 2에 있어서,

상기 도전층들은,

$\text{Cu}$ ,  $\text{Al}$ ,  $\text{Au}$ ,  $\text{Ag}$ ,  $\text{Ti}$ ,  $\text{V/Ni}$  중 하나 또는 둘 이상이 적층되어진 도전층인 것을 특징으로 하는 파워 모듈.

**청구항 6**

청구항 1 또는 2에 있어서,

상기 솔더층은,

SnAg, SnAgCu의 합금 솔더 페이스트(Solder Paste) 또는 솔더 플리폼(Solder Preform), Ag, 바나듐 니켈, 실버(Silver), SnAg, SnAgCu 합금 중 하나로 이루어진 솔더층인 것을 특징으로 하는 파워 모듈.

**청구항 7**

청구항 1 또는 2에 있어서,

상기 베이스 기판은,

Cu, Al, Ti, AlSiC, Al Clad Cu 중 하나인 것을 특징으로 하는 파워 모듈.

**청구항 8**

청구항 1 또는 2에 있어서,

상기 세라믹 코팅층의 두께는,

50 $\mu$ m ~ 200 $\mu$ m인 것을 특징으로 하는 파워 모듈.

**명세서**

**발명의 상세한 설명**

**기술분야**

[0001] 본 발명은 열 방출 효율을 증가시킬 수 있고, 제조 공정을 단순화하고, 제조 비용을 줄일 수 있는 파워 모듈 및 그의 제조 방법에 관한 것이다.

**배경 기술**

[0002] 파워 모듈은 DC-DC 컨버터와 인버터의 스위칭 부품을 사용한 전력 변환 장치로서 에너지 절약을 위하여 산업상, 가정용 등 많은 부문에 사용된다.

[0003] 이런 파워 모듈을 사용하는 고객은 고 효율, 낮은 가격, 높은 신뢰성을 요구하고 있어 파워 모듈의 열 성능을 향상과 동시에 신뢰성이 높은 파워 모듈의 개발을 통하여 이를 만족시키기 위해 노력하고 있다.

**발명의 내용**

**해결 하고자하는 과제**

[0004] 본 발명은 열 방출 효율을 증가시킬 수 있고, 제조 공정을 단순화하고, 제조 비용을 줄일 수 있는 과제를 해결 하는 것이다.

**과제 해결수단**

[0005] 본 발명의 바람직한 양태(樣態)는,

- [0006] 베이스 기판과;
- [0007] 상기 베이스 기판 상부에 형성된 세라믹 코팅층과;
- [0008] 상기 세라믹 코팅층 상부에 형성되고 이격된 도전층들과;
- [0009] 상기 도전층들 상부 각각에 솔더층으로 본딩된 파워 칩들을 포함하여 구성된 파워 모듈이 제공된다.

- [0010] 본 발명의 바람직한 다른 양태(樣態)는,
- [0011] 히트 싱크와;
- [0012] 상기 히트 싱크 상부에 형성된 세라믹 코팅층과;
- [0013] 상기 세라믹 코팅층 상부에 형성되고 이격된 도전층들과;
- [0014] 상기 도전층들 상부 각각에 솔더층으로 본딩된 파워 칩들을 포함하여 구성된 파워 모듈이 제공된다.

**효 과**

- [0015] 본 발명의 파워 모듈은 파워 칩에서 베이스 기판까지의 두께가 얇아져, 파워 칩에서 발생된 열이 방출 경로가 짧아 열 방출 효율을 증가시킬 수 있는 효과가 있다.
- [0016] 본 발명의 파워 모듈은 절연내압 특성을 만족하는 최소화의 세라믹 두께를 사용할 수 있어 열 저항을 감소시킬 수 있는 효과가 있다.
- [0017] 본 발명의 파워 모듈은 신뢰성에 취약했던 세라믹 기판과 베이스 기판의 접합층을 제거함으로써 신뢰성을 향상시킬 수 있는 효과가 있다.
- [0018] 본 발명의 파워 모듈은 구성요소를 줄일 수 있어 제조 공정을 단순화할 수 있고, 제조 비용을 줄일 수 있는 효과가 있다.

**발명의 실시를 위한 구체적인 내용**

- [0019] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 설명하면 다음과 같다.
- [0020] 도 1은 본 발명에 따른 파워 모듈의 개략적인 단면도로서, 베이스 기판(100)과; 상기 베이스 기판(100) 상부에 세라믹 코팅층(110)과; 상기 세라믹 코팅층(110) 상부에 형성되고 이격된 제 1과 2 도전층(121,122)과; 상기 제 1과 2 도전층(121,122) 상부 각각에 제 1과 2 솔더층(131,132)으로 본딩된 제 1과 2 파워 칩들(151,152)과; 상기 파워 칩들(151,152)을 내장하는 케이스(180)와; 상기 케이스(180) 상부에 형성된 제 1 터미널 단자(161a)에 연결되고, 상기 제 1 도전층(121)에 제 3 솔더층(133)으로 연결된 제 1 핀(161)과; 상기 케이스(180) 상부에 형성된 제 2 터미널 단자(161b)에 연결되고, 상기 제 2 도전층(122)에 제 4 솔더층(134)으로 연결된 제 2 핀(162)과; 상기 제 1 파워 칩(151)과 제 2 도전층(122)에 본딩되어 있고, 상기 제 2 파워 칩(152)과 상기 제 2 핀(162)에 본딩되어 있는 와이어들(191,192)과; 상기 케이스(180) 내부에 충전된 겔(170)을 포함하여 구성된다.
- [0021] 여기서, 본 발명의 파워 모듈은 상기 제 1과 2 파워 칩들(151,152)과 같이, 2개의 파워 칩들은 최소 단위이고, 2개의 파워 칩들만 내장된 것이 아니고, 복수개의 파워 칩을 내장할 수 있는 것이다.
- [0022] 즉, 본 발명의 파워 모듈은 베이스 기판(100)과; 상기 베이스 기판(100) 상부에 저온 분사(Cold spray) 코팅된 세라믹 코팅층(110)과; 상기 세라믹 코팅층(110) 상부에 형성되고 이격된 도전층들(121,122)과; 상기 도전층들(121,122) 상부 각각에 솔더층(131,132)으로 본딩된 파워 칩들을 포함하여 구성되는 것이다.
- [0023] 그리고, 파워 모듈은 정류 특성을 가지는 다이오드들이 실장될 수 있다.
- [0024] 또, 상기 세라믹 코팅층(110)은 전기적 절연이 확보되고, 열을 외부로 방열할 수 있는 높은 절연저항과 열전도율이 높은 재료를 적용하는 형성하는 것이 바람직하며, 특히, SiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, AlN, Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, BeO 중 하나로 형성된

세라믹 코팅층을 적용하는 것이 바람직하다.

- [0025] 그리고, 상기 세라믹 코팅층(110)은 SiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, AlN, Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, BeO 중 하나를 포함하는 세라믹 분말을 페이스트 상태로 인쇄 또는 제트(Jet) 분사 방법으로 형성되어진 세라믹 코팅층으로 구성할 수도 있다.
- [0026] 또한, 상기 도전층들(121,122)은 STC(Sputtered Thick Coating)을 이용하여 전기 전도성과 열 전도율이 좋은 Cu, Al, Au, Ag, Ti, V/Ni 중 하나 또는 둘 이상 이상이 적층되어진 도전층인 것이 바람직하다.
- [0027] 더불어, 상기 베이스 기판(100)의 재질은 Cu, Al, Tu, SiC, AlSiC, Al Clad Cu 중 하나인 것이 바람직하다.
- [0028] 게다가, 상기 솔더층은 SnAg, SnAgCu의 합금 솔더 페이스트(Solder Paste) 또는 솔더 플리폼(Solder Preform), Ag, 바나듐 니켈, 실버(Silver), SnAg, SnAgCu 합금 중 하나로 이루어진 솔더층인 것이 바람직하다.
- [0029] 여기서, 상기 Ag, 바나듐 니켈, 실버(Silver), SnAg, SnAgCu 합금은 STC(Sputtered Thick Coating)을 이용하여 솔더층을 형성할 수 있다.
- [0030] 도 2a 내지 도 2d는 본 발명에 따라 파워 모듈을 제조하는 방법을 설명하기 위한 개략적인 단면도로서, 먼저, 베이스 기판(100) 상부에 세라믹 코팅층(110)을 코팅하고, 상기 세라믹 코팅층(110) 상부에 이격된 제 1과 2 도전층(121,122)을 형성한다.(도 2a)
- [0031] 상기 제 1과 2 도전층(121,122)은 STC(Sputtered Thick Coating) 기술을 이용하여 전기 전도 금속층으로 형성하는 것이 바람직하다.
- [0032] 그리고, 상기 세라믹 코팅층(110)은 저온 분사(Cold spray) 코팅되는 것이 바람직하다.
- [0033] 그 다음, 상기 제 1과 2 도전층(121,122) 상부 각각에 제 1과 2 솔더층(131,132)을 형성한다.(도 2b)
- [0034] 이후, 상기 제 1과 2 솔더층(131,132) 각각에 제 1과 2 파워 칩(151,152)을 본딩한다.(도 2c)
- [0035] 즉, 본 발명의 파워 모듈을 제조하는 방법은 전술된 도 2a 내지 도 2c의 공정을 포함하여 구성된다.
- [0036] 계속된 공정을 수행하여, 도 2d와 같은 구조를 형성할 수 있다.
- [0037] 즉, 상기 파워 칩들(151,152)을 내장하는 케이스(180), 상기 케이스(180) 상부에 형성된 제 1 터미널 단자(161a)에 연결되고 상기 제 1 도전층(121)에 제 3 솔더층(133)으로 연결된 제 1 핀(161), 상기 케이스(180) 상부에 형성된 제 2 터미널 단자(161b)에 연결되고 상기 제 2 도전층(122)에 제 4 솔더층(134)으로 연결된 제 2 핀(162), 상기 제 1 파워 칩(151)과 제 2 도전층(122)에 본딩되어 있고 상기 제 2 파워 칩(152)과 상기 제 2 핀(162)에 본딩되어 있는 와이어들(191,192)과, 상기 케이스(180) 내부에 충전된 겔(170)을 형성한다.
- [0038] 그리고, 상기 케이스(180), 제 1 터미널 단자(161a), 제 3 솔더층(133), 제 1 핀(161), 제 2 터미널 단자(161b), 제 4 솔더층(134), 제 2 핀(162), 와이어들(191,192)과 겔(170)을 형성하는 공정은 파워 모듈을 구성하는 일례의 방법으로 다양하게 변형될 수 있다.
- [0039] 도 3은 본 발명에 따른 비교예의 파워 모듈을 제조하는 일부 방법을 설명하기 위한 개략적인 단면도이고, 도 5는 본 발명에 따른 실시예의 파워 모듈을 제조하는 일부 방법을 설명하기 위한 개략적인 단면도이다.
- [0040] 비교예의 파워 모듈의 제조 방법은 도 3과 같이, 베이스 기판(300) 상부에 하부 솔더층(301)을 형성하고, 상기 베이스 기판(300)과 별도로 준비된 세라믹 기판(311)의 구리층(미도시) 상부에 상부 솔더층(312)을 형성한 다음, 상기 상부 솔더층(312)에 파워 칩(320)을 본딩한다.
- [0041] 여기서, 본 발명은 상기 베이스 기판(300)을 히트 싱크로 적용할 수 있다.
- [0042] 그 후, 상기 파워 칩(320)이 본딩된 세라믹 기판(311)을 상기 베이스 기판(300) 상부에 형성된 하부 솔더층(301)에 본딩하는 공정을 수행한다.
- [0043] 여기서, 상기 세라믹 기판(313)의 하부에는 구리층이 형성되어 있다.
- [0044] 계속하여, 상기 세라믹 기판(311)이 본딩된 베이스 기판(300)을 소정온도에서 솔더링한다.
- [0045] 그리고, 본 발명의 파워 모듈의 제조 방법은 도 5에 도시된 바와 같이, 베이스 기판(100) 상부에 저온 분사

(Cold spray)하여 세라믹 코팅층을 코팅하고, 상기 세라믹 코팅층 상부에 스퍼터링 증착 및 패터닝 공정을 수행하여 도전층들을 형성하고, 상기 도전층들 상부 각각에 솔더층(120)을 형성한 다음, 상기 솔더층(120) 각각에 파워 칩들(150)을 본딩한다.

- [0046] 그 후, 상기 파워 칩들(150)이 본딩된 베이스 기판(100)을 소정온도에서 솔더링한다.
- [0047] 도 4는 본 발명에 따른 비교예의 파워 모듈의 일부 단면도이고, 도 6은 본 발명에 따른 실시예의 파워 모듈의 일부 단면도이다.
- [0048] 비교예의 파워 모듈은 도 4에 도시된 바와 같이, 베이스 기판(300) 상부에 하부 솔더층(301)이 형성되어 있고, 상기 하부 솔더층(301) 상부에 세라믹 기판(311)의 하부에 형성된 구리층(313)이 본딩되어 있으며, 상기 세라믹 기판(311) 상부에 구리층(312a,312b)이 형성되어 있다.
- [0049] 여기서, 상기 세라믹 기판(311)과; 상기 세라믹 기판(311)의 하부 및 상부에 형성된 구리층(312a,312b,313)을 DBC(Direct Bonded Copper)(310)라 지칭할 수 있다.
- [0050] 그리고, 본 발명의 파워 모듈은 도 6과 같이, 베이스 기판(100) 상부에 세라믹 코팅층(110)과 도전층(121,122)이 형성되어 있다.
- [0051] 그러므로, 비교예의 파워 모듈은 파워 칩에서 발생된 열이 상부 솔더층, 구리층(312a,312b), 세라믹 기판(311), 구리층(313), 하부 솔더층(301)을 통하여 베이스 기판(300)에 전달되는 열 방출 경로를 갖는다.
- [0052] 즉, 비교예의 파워 모듈은 Power Semiconductor(R1), Soler 1(R2), Ceramic 기판 Conductor 1(R3), Ceramic(R4), Ceramic 기판 Conductor 2(R5), Soler 2(R6), Base plate(R7)로 구성된 열 방출 경로를 갖는다.
- [0053] 반면에, 본 발명의 파워 모듈은 파워 칩에서 발생된 열이 솔더층, 도전층(121,122), 세라믹 코팅층(110)을 통하여 베이스 기판(300)에 전달되는 열 방출 경로를 갖는다.
- [0054] 즉, 본 발명의 파워 모듈은 Power Semiconductor(R1), Soler 1(R2), Conductor 1(R3), Ceramic(R4), Base plate(R5)로 구성된 열 방출 경로를 갖는다.
- [0055] 따라서, 본 발명의 파워 모듈은 비교예의 파워 모듈보다도 파워 칩에서 베이스 기판까지의 두께가 얇아져, 파워 칩에서 발생된 열이 방출 경로가 비교예의 파워 모듈보다 짧아 열 방출 효율을 증가시킬 수 있는 장점이 있다.
- [0056] 한편, 도 6의 도전층(121,122)은 알루미늄층(A1)층을 형성하고 그 알루미늄층 상부에 구리(Cu)층이 적층된 구조로 구성될 수 있다.
- [0057] 그리고, 비교예의 파워 모듈은 세라믹 기판(311)의 두께(t1)가 두껍고, 본 발명의 파워 모듈은 세라믹 코팅층(110)의 두께(t2)가 얇아, 절연내압 특성을 만족하는 최소화의 세라믹 두께를 사용할 수 있어 열 저항을 감소시킬 수 있는 장점이 있다.
- [0058] 여기서, 상기 세라믹 코팅층(110)의 두께(t2)는 절연내압 특성을 만족시키기 위하여 50 $\mu$ m ~ 200 $\mu$ m인 것이 바람직하고, 이 범위 이외에서는 절연내압 특성이 만족되지 않는다.
- [0059] 또한, 전술된 바와 같이, 본 발명의 파워 모듈은 비교예의 파워 모듈과 대비하여 신뢰성에 취약했던 세라믹 기판과 베이스 기판의 접합층을 제거함으로써 신뢰성을 향상시킬 수 있는 장점이 있다.
- [0060] 즉, 상기 세라믹 기판과 베이스 기판의 접합층인 솔더는 박리 및 크랙이 발생될 수 있으므로, 파워 모듈의 신뢰성을 저하시키는 요인이 된다.
- [0061] 더불어, 본 발명은 파워 모듈의 구성요소를 줄일 수 있어 제조 공정을 단순화할 수 있고, 제조 비용을 줄일 수 있는 장점이 있다.
- [0062] 본 발명은 구체적인 예에 대해서만 상세히 설명되었지만 본 발명의 기술사상 범위 내에서 다양한 변형 및 수정이 가능함은 당업자에게 있어서 명백한 것이며, 이러한 변형 및 수정이 첨부된 특허청구범위에 속함은 당연한

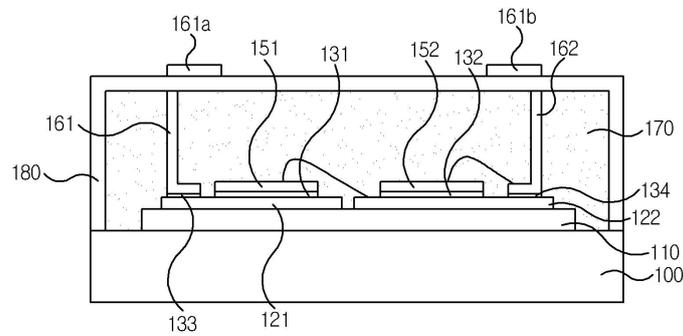
것이다.

**도면의 간단한 설명**

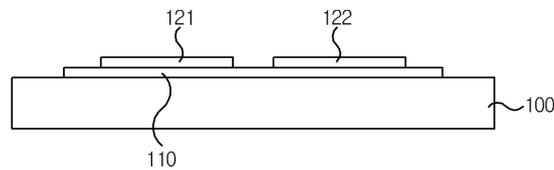
- [0063] 도 1은 본 발명에 따른 파워 모듈의 개략적인 단면도
- [0064] 도 2a 내지 도 2d는 본 발명에 따라 파워 모듈을 제조하는 방법을 설명하기 위한 개략적인 단면도
- [0065] 도 3은 본 발명에 따른 비교예의 파워 모듈을 제조하는 일부 방법을 설명하기 위한 개략적인 단면도
- [0066] 도 4는 본 발명에 따른 비교예의 파워 모듈의 일부 단면도
- [0067] 도 5는 본 발명에 따른 실시예의 파워 모듈을 제조하는 일부 방법을 설명하기 위한 개략적인 단면도
- [0068] 도 6은 본 발명에 따른 실시예의 파워 모듈의 일부 단면도

**도면**

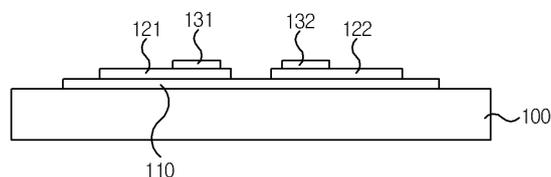
**도면1**



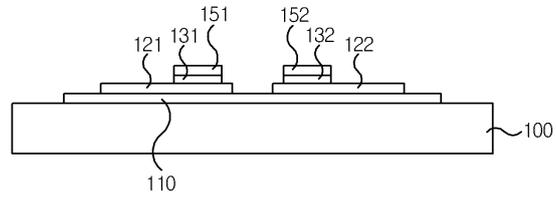
**도면2a**



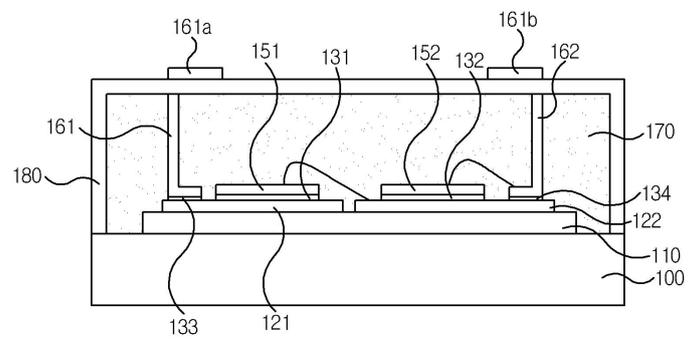
**도면2b**



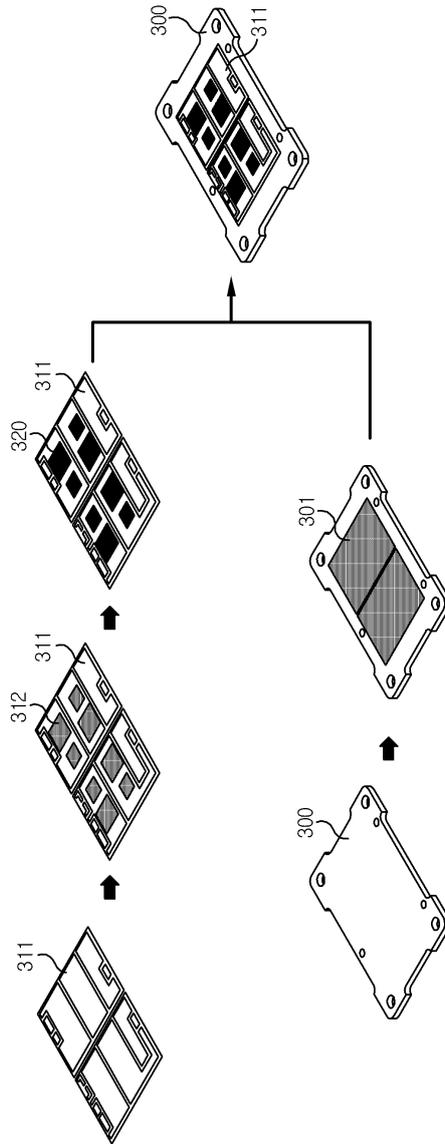
도면2c



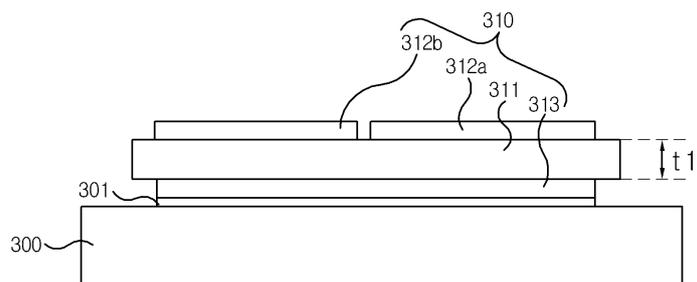
도면2d



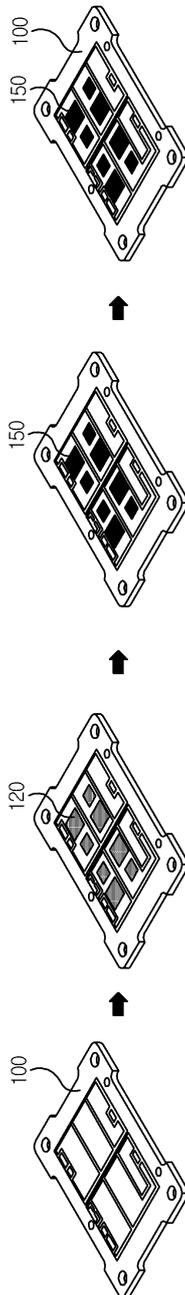
도면3



도면4



도면5



도면6

